

平成 30 年 1 月 29 日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第 145 委員会  
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会  
第 157 回研究会 開催通知

第 145 委員会, 第 161 委員会 合同研究会

テーマ: 「次世代パワーデバイス開発における要素技術の進展」

日時: 2018 年 3 月 2 日 (金) 13:00~

会場: 名古屋大学 ナショナル イノベーション コンプレックス (NIC) Idea Stoa  
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 <http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/>

世話人: 三宅秀人 (三重大学), 朝日聡明 (JX 金属), 松本康裕 (Sunric)  
宇治原徹 (名古屋大学), 寒川義裕 (九州大学) (以上, 第 161 委員会)  
上田 修 (金沢工業大学), 酒井 朗 (大阪大学) (以上, 第 145 委員会)

プログラム

13:00~13:05 開会挨拶 藤岡 洋 (東京大学)

13:05~13:45 「GaN 分極スーパー Junction トランジスタとダイオード」  
河合 弘治 (パウデック)

13:45~14:25 「GaN 縦型パワーデバイス実現に向けたエピタキシャル成長・デバイス  
プロセスの現状と課題」  
須田 淳 (名古屋大学)

14:25~15:05 「縦型 GaN パワーデバイスの進展」  
岡 徹 (豊田合成)

15:05~15:20 休憩

15:20~16:00 「次世代電力エネルギー社会のためのグリーンエレクトロニクスシステム」  
西澤 伸一 (九州大学)

16:00~16:40 「SiC パワーデバイスの高耐熱実装と信頼性」  
長尾 至成 (大阪大学)

16:40~17:20 「高密度実装に向けた素子温度 200°C 対応疲労抑制構造 SiC パワーモジュール」  
道越 久人 (AIST)

17:30~19:30 意見交換会 (NIC 大会議室)

以上